

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Ларионов Ю. В. Вариация изображения выступа в ходе его многократного сканирования в низковольтном РЭМ 659

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

Шукевич Я. И., Баркалин В. В., Таратын И. А., Реутская О. Г. Моделирование динамики работы СВЧ МЭМС-переключателя 666

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

Рубан О. А. Исследование поляризации в гетероструктурах с квантовой ямой AlGaIn/GaN методом вольт-фарадных характеристик 675

Барулина М. А., Панкратов В. М. Аналитическое решение плоской нестационарной задачи теплопроводности для фотонно-кристаллического волокна с воздушным сердечником 680

Тонолов В. Ю., Ермаков И. А. Пьезоэлектрические свойства и гидростатические параметры нового 2—0—2-композиата на основе кристалла релаксор-сегнетоэлектрика 692

Рембеза С. И., Кошелева Н. Н., Свистова Т. В., Рембеза Е. С., Аганов Б. Л., Плотникова Е. Ю., Белоусов С. А., Носов А. А. Электрофизические свойства пленок $(\text{SnO}_2)_x(\text{ZnO})_{1-x}$ ($x = 0 \dots 0.5$) для прозрачной электроники 699

Данилина Т. И., Чистоедова И. А., Понов А. А. Формирование микрорельефа и исследование его влияния на коэффициент оптического вывода светодиода на основе GaN 708

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Смолин В. К. Высокочастотная микроэлектроника на структурах с кремниевыми подложками 713

Аннотации на русском и английском языках с 1999 г. по настоящее время находятся в свободном доступе на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) и научной электронной библиотеки (<http://elibrary.ru>). Электронные версии полнотекстовых статей расположены на сайте журнала: с 1999 по 2014 г. в разделе "АРХИВ".